



3.1W单声道、超低EMI、无滤波器D类音频功放

概要

CS8126T是一款高效率，超低EMI，3.1W单声道D类音频放大器。CS8126T无需滤波器的PWM调制结构减少了外部元件、PCB面积和系统成本，而且也简化了设计。高达90%的效率，快速的启动时间和纤小的封装尺寸使得CS8126T成为小型手上设备和PDA的最佳选择。

CS8126T的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了CS8126T对RF噪声的抑制能力,并且省去了传统音频功放的BYPASS电容。

CS8126T采用独创的AERC(Adaptive Edge Rate Control)技术,能提供优异的全带宽EMI抑制能力,在不加任何辅助设计时,在FCC Part15 Class B标准下仍然具有超过20dB的裕量。CS8126T内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS8126T提供了纤小的DFN2X2_8L封装形式可供客户选择,其额定的工作温度范围为-40°C至85°C。

封装

DFN2*2_8L

描述

• 输出功率

PO at 10% THD+N, $V_{DD} = 5V$
 $RL = 8\ \Omega$ 1.8W(典型值)
 $RL = 4\ \Omega$ 3.1W(典型值)

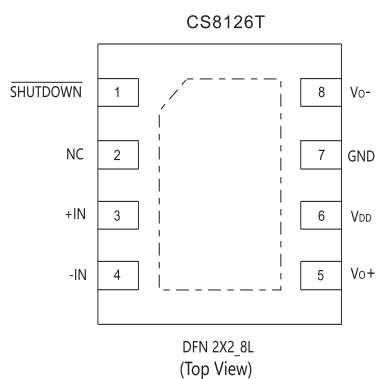
PO at 1% THD+N, $V_{DD} = 3.6V$
 $RL = 8\ \Omega$ 0.74W(典型值)
 $RL = 4\ \Omega$ 1.30W(典型值)

- 独创的AERC技术,提供优异的全带宽EMI抑制能力
- 优异的"噼噍-咔嚓"(pop-noise)杂音抑制能力
- 工作电压范围: 2.5V到5.5V
- 无需滤波的Class-D结构
- 高达90%的效率
- 高的电源抑制比(PSRR): 在217Hz下为-80dB
- 快速的启动时间(32ms)
- 低静态电流(4mA)
- 低关断电流($< 0.1\ \mu A$)
- 过流保护, 短路保护和过热保护
- 符合Rohs标准的无铅封装

应用：

- 手机/PDA
- USB音箱/便携式音箱
- PMP/MP4/MP5播放器
- GPS

引脚分布



典型应用图

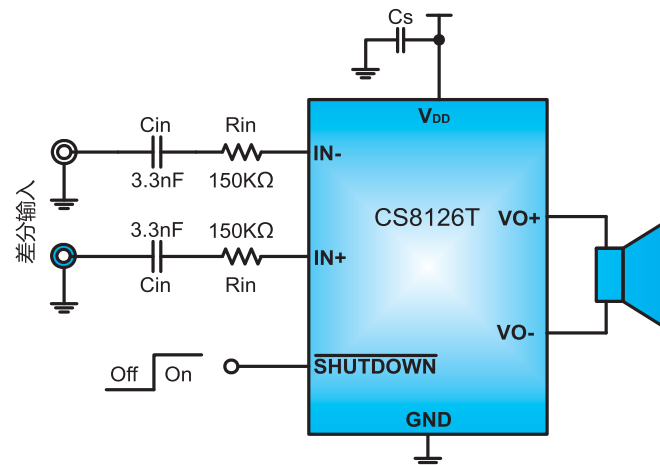


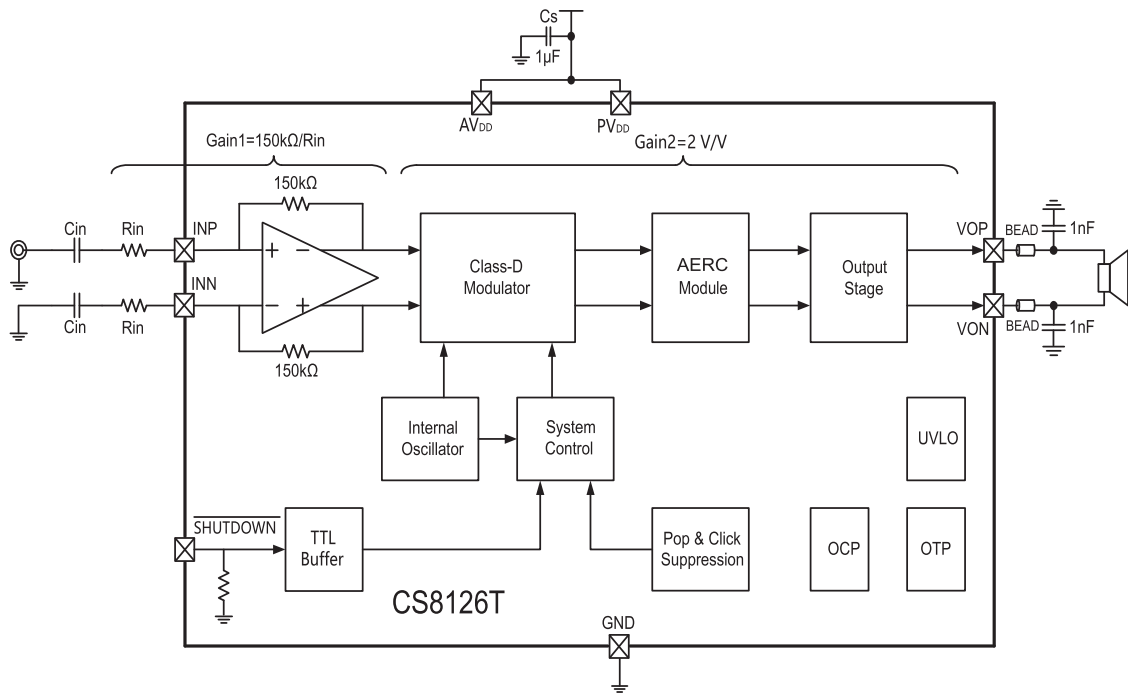
图1 CS8126T 差分输入方式应用图



引脚定义以及功能

序号	符号	描述
1	$\overline{\text{SHUTDOWN}}$	关断
2	NC	无连接
3	+IN	正相音频输入
4	-IN	反相音频输入
5	VO+	正相音频输出
6	V _{DD}	电源
7	GND	地
8	VO-	反相音频输出

功能框图



CS8126T功能框图



极限参数表¹

参数	描述	数值	单位
V_{DD}	无信号输入时供电电源	6	V
V_I	输入电压	-0.3 to $V_{DD}+0.3$	V
T_J	结工作温度范围	-40 to 150	°C
T_{SDR}	引脚温度 (焊接10秒)	260	°C
T_{STG}	存储温度范围	-65 to 150	°C

推荐工作环境

参数	描述	数值	单位
V_{DD}	输入电压	2.5~5.5	V
T_A	环境温度范围	-40~85	°C
T_j	结温范围	-40~125	°C

热效应信息²

参数	描述	数值	单位
$\theta_{JA}(DFN8)$	封装热阻---芯片到环境热阻	80	°C/W

订购信息

产品型号	封装形式	器件标识	包装尺寸	卷带宽度	数量
CS8126T	DFN2X2_8L		7"	8mm	3000 units

ESD 范围

ESD 范围HBM(人体静电模式) ----- ±4kV
ESD 范围MM(机器静电模式) ----- ±400V

1. 上述参数仅仅是器件工作的极限值，不建议器件的工作条件超过此极限值，否则会对器件的可靠性及寿命产生影响，甚至造成永久性损坏。
2. PCB板放置CS8126T的地方,需要有散热设计.使得CS8126T底部的散热片和PCB板的散热区域相连，并通过过孔和地相连。



电气参数

T_A = 25°C (除非特殊说明)

参数	描述	测试条件	最小	典型值	最大	单位
V _{oo}	输出失调电压	V _{IN} =0V, A _v =2V/V V _{DD} =2.5V to 5.5V		5	25	mV
PSRR	电源抑制比	V _{DD} =2.5V to 5.5V, 217Hz		-80		dB
CMRR	共模抑制比	输入管脚短接, V _{DD} =2.5V to 5.5V		-70		dB
I _{IH}	高电平输入电流	V _{DD} =5.5V, V _I =V _{DD}			50	μA
I _{IL}	低电平输入电流	V _{DD} =5.5V, V _I =0V		5		μA
I _{DD}	静态电流	V _{DD} =5.5V, 无负载, 无滤波		4		mA
		V _{DD} =3.6V, 无负载, 无滤波		3		
I _{SD}	关断电流			0.1		μA
r _{DS(ON)}	源漏导通电阻	V _{DD} =5.5V		250		mΩ
		V _{DD} =3.6V		320		
	关断状态下输出阻抗	V _(SHUTDOWN) =0.35V		2		KΩ
f _(SW)	调制频率	V _{DD} =2.7V to 5.5V		500		KHz
Gain	放大倍数			$\frac{2 \times 160k\Omega}{R_{in}}$		V/V
R _{SD}	SHUTDOWN 引脚下拉电阻			300		KΩ

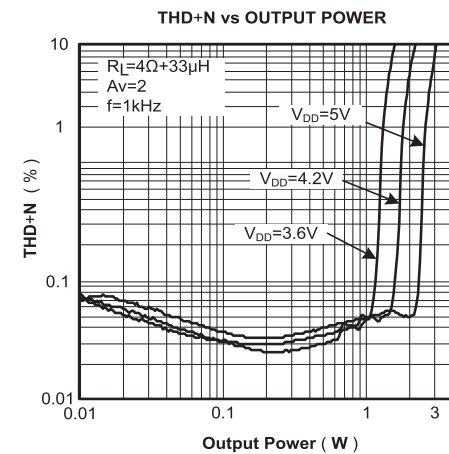
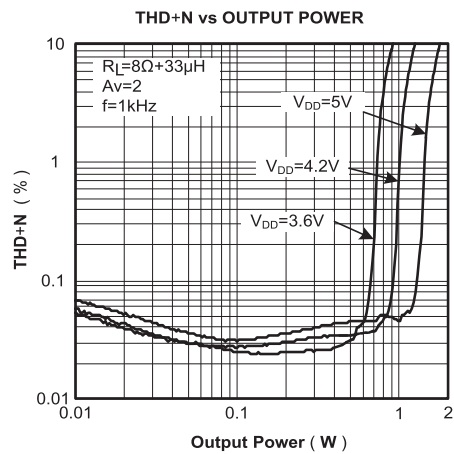
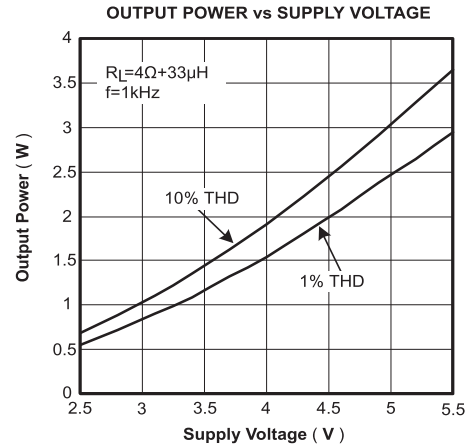
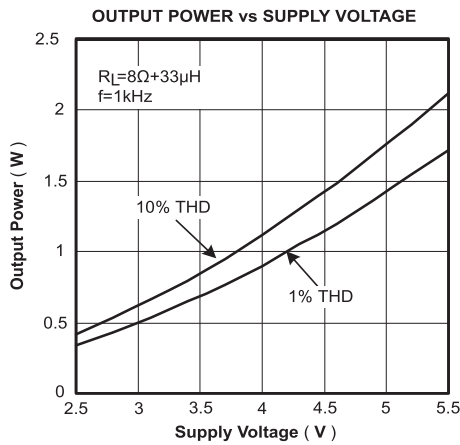
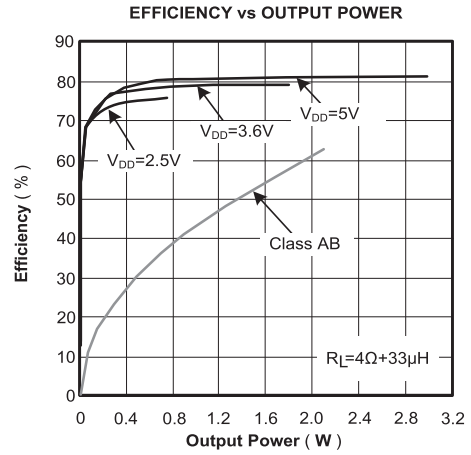
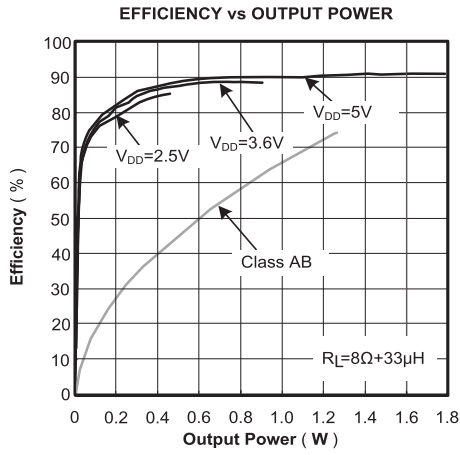
工作特性

T_A=25°C, Gain = 2 V/V, R_L = 8 Ω (除非特殊说明)

参数	描述	测试条件	最小	典型	最大	单位
P _O	输出功率	V _{DD} =5.0V, THD=10%, f=1KHz, R _L =4Ω		3.10		W
		V _{DD} =5.0V, THD=1%, f=1KHz, R _L =4Ω		2.50		
		V _{DD} =5.0V, THD=10%, f=1KHz, R _L =8Ω		1.80		
		V _{DD} =5.0V, THD=1%, f=1KHz, R _L =8Ω		1.47		
		V _{DD} =4.2V, THD=10%, f=1KHz, R _L =4Ω		2.45		
		V _{DD} =4.2V, THD=1%, f=1KHz, R _L =4Ω		2.00		
		V _{DD} =4.2V, THD=10%, f=1KHz, R _L =8Ω		1.30		
		V _{DD} =4.2V, THD=1%, f=1KHz, R _L =8Ω		1.10		
		V _{DD} =3.6V, THD=10%, f=1KHz, R _L =4Ω		1.59		
		V _{DD} =3.6V, THD=1%, f=1KHz, R _L =4Ω		1.28		
		V _{DD} =3.6V, THD=10%, f=1KHz, R _L =8Ω		0.91		
		V _{DD} =3.6V, THD=1%, f=1KHz, R _L =8Ω		0.75		
THD+N	总谐波失真+噪声	V _{DD} =5.0V, P _O =0.6W, f=1KHz, R _L =8Ω		0.020		%
		V _{DD} =4.2V, P _O =0.4W, f=1KHz, R _L =8Ω		0.030		
		V _{DD} =3.6V, P _O =0.4W, f=1KHz, R _L =8Ω		0.028		
η	效率	V _{DD} =5.0V, P _O =0.6W, f=1KHz, R _L =8Ω		90		%
t _{ST}	启动时间			32		ms

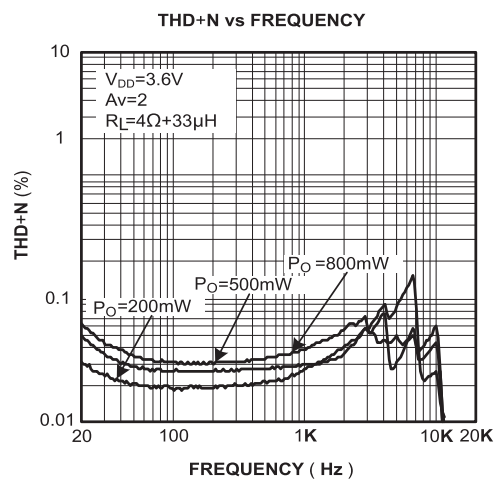
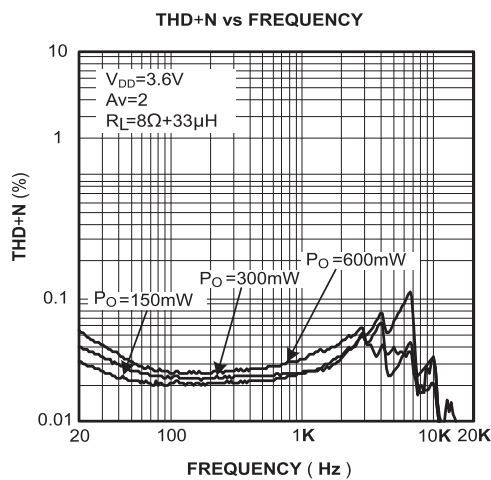
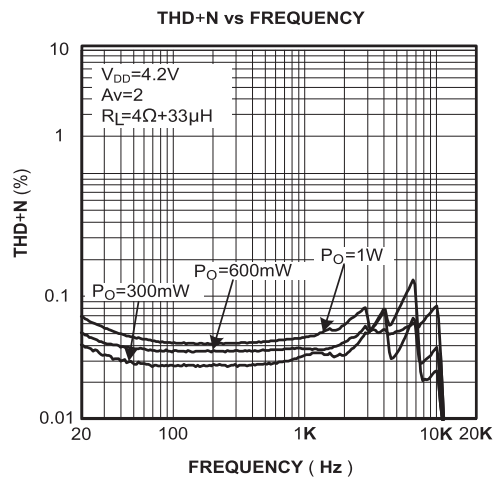
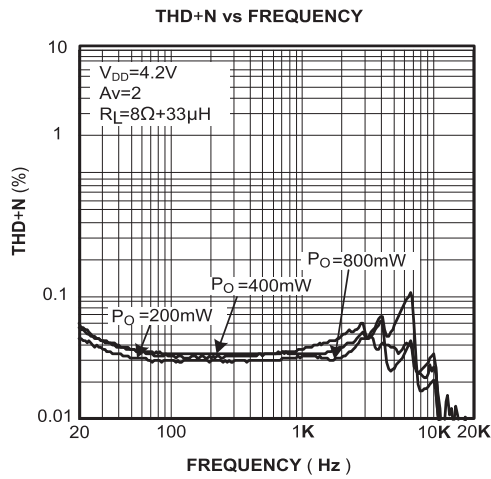
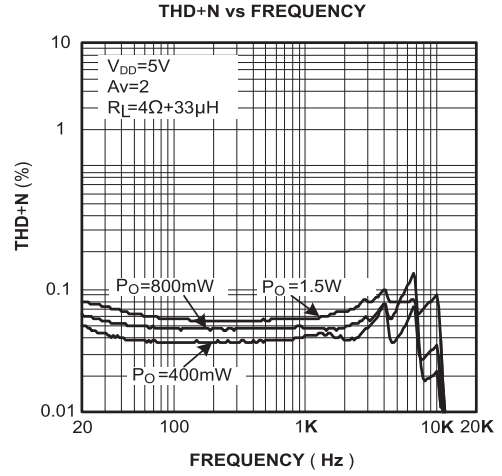
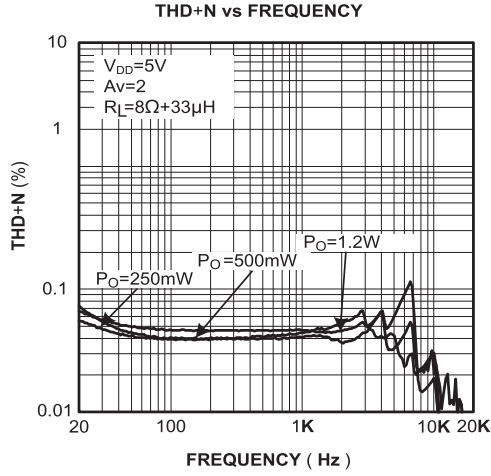


典型特征曲线 $T_A=25^\circ\text{C}$, Gain = 2 V/V, $R_L = 8\ \Omega$ (除非特殊说明)



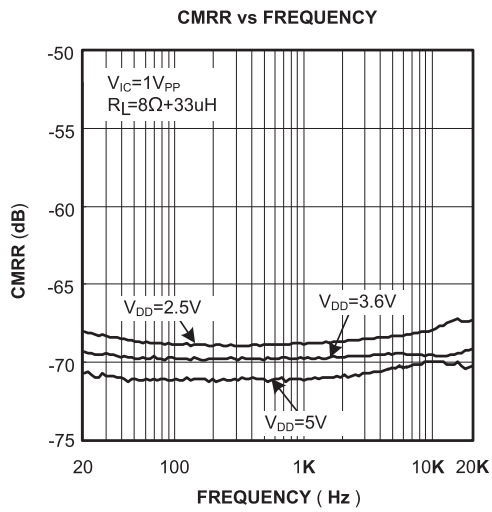
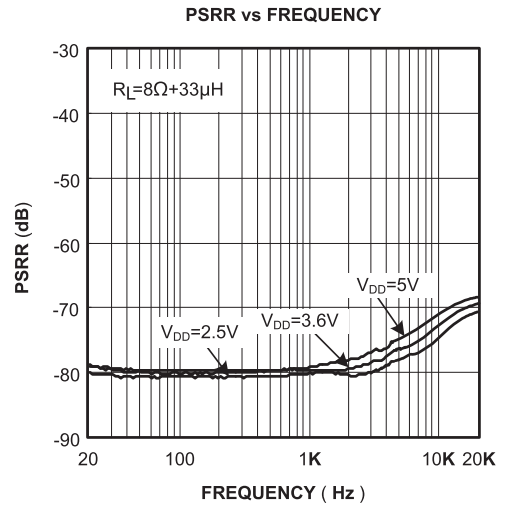
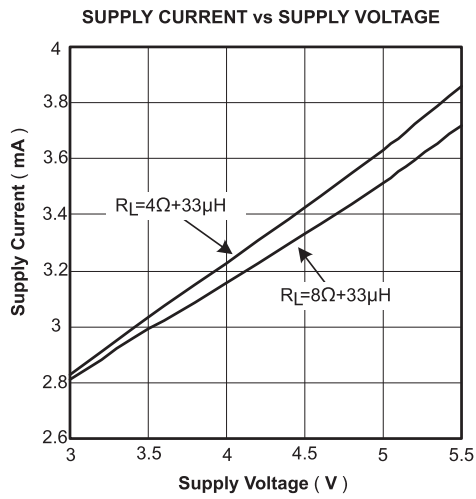


典型特征曲线 $T_A=25^\circ\text{C}$, Gain = 2 V/V, $R_L = 8\ \Omega$ (除非特殊说明)





典型特征曲线 $T_A=25^{\circ}\text{C}$, Gain = 2 V/V, $R_L = 8\ \Omega$ (除非特殊说明)

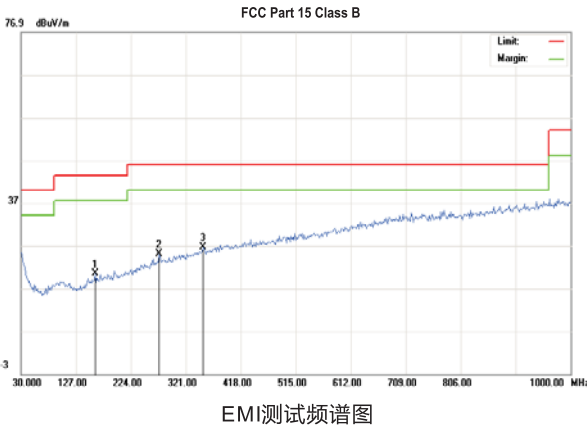




产品特性

CS8126T是一款超低EMI,3.1W,单声道,D类音频功率放大器。在5V电源下,能够向4Ω负载提供3.1W的输出功率,并具有高达90%的效率。

CS8126T采用专有的AERC((Adaptive Edge Rate Control)技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,对60cm的音频线,在FCC的标准下具有超过20dB的裕量(如下图)。



CS8126T无需滤波器的PWM调制结构减少了外部元件数目,PCB面积和系统成本,并且简化了设计。芯片内置了过流保护,过热保护盒欠压保护功能,这些功能保证了芯片在异常的工作条件下关断芯片,有效地保护了芯片不被损坏,当异常条件消除后,CS8126T有自恢复功能可以让芯片重新工作。

效率

输出晶体管的开关工作方式决定了D类放大器的高效率。在D类放大器重,输出晶体管就像是一个电流调整开关,切换过程中消耗的额外功率基本可以忽略不计。输出级相关的功率损耗主要是由MOSFET导通电阻与电源电流产生的 I^2R 。CS8126T的效率可达90%。

无需滤波器

CS8126T采用无需滤波器的PWM调制方式,省去了传统D类放大器的LC滤波器,提高了效率,为便携式设备的音频子系统提供了一个更小面积,更低成本的实现方案。

Pop & Click抑制

CS8126T内置专有的时序控制电路,实现全面的Pop & Click抑制,可以有效地消除系统在上电,下电,Wake up和Shutdown操作时可能会出现瞬态噪声。

保护电路

CS8126T在应用的过程中,当芯片发生输出管脚和电源或地短路,或者输出之间的短路故障时,过流保护电路会关断芯片以防止芯片被损坏。短路故障消除后,CS8126T自动恢复工作。当芯片温度过高时,芯片也会被关断。温度下降后,CS8126T可以继续正常工作。当电源电压过低时,芯片也将被关断,电源电压恢复后,芯片会再次启动。

应用信息

去耦电容 (C_S)

CS8126T是一款高性能D类音频放大器,电源端需要加适当的电源供电去耦电容来确保其高效率 and 最佳的总谐波失真。同时为得到良好的高频瞬态性能,希望电容的ESR值要尽量的小,一般选择典型值为1 μ F的电容旁路到地。去耦电容在布局上应该尽可能的靠近芯片的V_{DD}放置。把去耦电容放在与CS8126T较近的地方对于提高D类放大器的效率非常重要。因为器件和电容间的任何电阻或自感都会导致效率的降低。如果希望更好的滤掉低频噪音,则需要根据具体应用添加一个10 μ F或者更大的去耦电容。

输入电阻 (R_{in})

通过设定输入电阻可以设定系统的放大倍数,如下式:

$$\text{Gain} = \frac{2 \times 160\text{k}\Omega}{R_{in}} \left(\frac{V}{V} \right)$$

两个输入电阻之间的良好匹配对提升芯片PSRR,CMRR以及THD等性能都有帮助,因此要求使用精度为1%的电阻。PCB布局时,电子应紧靠CS8126T放置,可以防止噪声从高阻结点的引入。

输入电容 (C_{in})

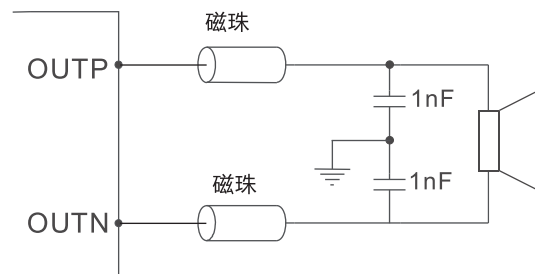
输入电阻和输入电容之间构成了一个高通滤波器,其截止频率如下式:

$$f_c = \frac{1}{(2\pi R_{in} C_{in})}$$

输入电容的值非常重要,一般认为它直接影响着电路的低频性能。无线电话中的喇叭对于低频信号通常不能很好的响应,可以在应用中选取比较大的 f_c 以滤除217HZ噪声引入的干扰。电容之间良好的匹配对提升芯片的整体性能和Pop & Click的抑制都有帮助,因此要求选取精度为10%或者更小的电容。

磁珠和电容

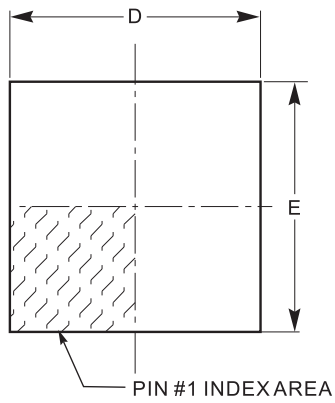
CS8126T在没有磁珠和电容的情况下,对于60cm的音频线,仍可满足FCC标准的要求。在输出音频线过长或器件布局靠近EMI敏感设备时,建议使用磁珠,电容。磁珠和电容要尽量靠近CS8126T放置。



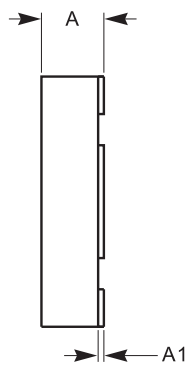


封装信息

CS8126T DFN 2X2_8L

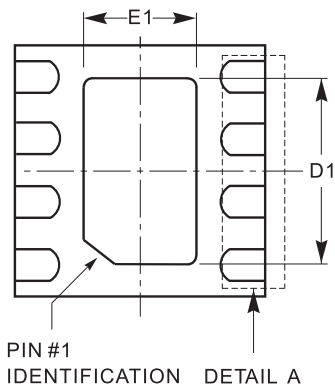


TOP VIEW

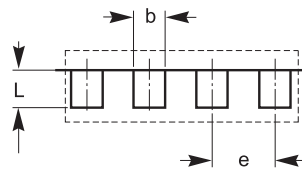


SIDE VIEW

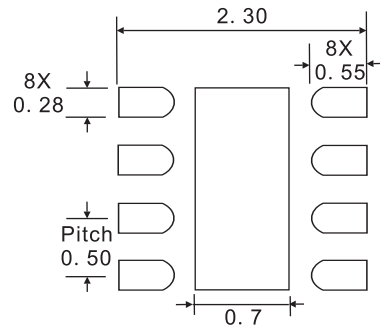
SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	0.70	0.75	0.80
A1	0.00	0.02	0.05
b	0.18	0.25	0.30
D	2.00BSC		
D1	1.10	1.20	1.30
E	2.00BSC		
E1	0.50	0.60	0.70
e	0.50 BSC		
L	0.30	0.35	0.40



BOTTOM VIEW



DETAIL A



UNIT:mm

Recommended Land Pattern

Notes:

- (1) 所有尺寸都为毫米
- (2) 参考JEDEC MO-229标准